#### Работа 3.3.6

# Влияние магнитного поля на проводимость полупроводников

**Цель работы:** измерение магнетосопротивления полупроводниковых образцов различной формы.

Оборудование: стабилизированный источник постоянного тока и напряжения, электромагнит, цифровой вольтметр, амперметр, миллиамперметр, реостат, измеритель магнитной индукции Ш1-10, образцы (InSb) монокристаллического антимонида индия n-типа.

#### 1. Теоретическая справка

**Выражение для магнетосопротивления.** Рассмотрим проводник с током, помещенный в магнитное поле. Пусть его вектор индукции  $\vec{B}$  направлен перпендикулярно вектору напряженности электрического поля  $\vec{E}$  (эффектом Холла пренебрегаем). Тогда усредненное по времени уравнение движения в стационарном состоянии имеет вид (здесь и далее все скорости считаются усредненными по времени)

$$\vec{E} + \frac{\vec{v}}{b} + \vec{v} \times \vec{B} = 0, \tag{1}$$

здесь b — подвижность электронов,  $\vec{v}$  — скорость. Если электрическое поле направлено вдоль оси x, то отсюда получим выражение для проекции скорости электрона на эту ось:

$$v_x = -\frac{bE}{1 + (bB)^2} \tag{2}$$

Из этого выражения получаем эффективный коэффициент подвижности  $b^*$ :

$$b^* = -\frac{v_x}{E} = \frac{b}{1 + (bB)^2}. (3)$$

Подставим это в формулу для удельного сопротивления  $\rho$ :

$$\rho = \frac{1}{enb^*} = \frac{1}{enb} \left( 1 + (bB)^2 \right) = \rho_0 \left( 1 + (bB)^2 \right), \tag{4}$$

где  $\rho_0$  - удельное сопротивление в отсутствии магнитного поля. Таким образом, искомая зависимость квадратична, и линейна в координатах  $\rho\left(B^2\right)$ . Зависимость сопротивления R от B имеет такой же вид, т.к.  $R=A\rho$ , где A зависит только от геометрических параметров.

**Диск Корбино.** Формула (4) справедлива при условии  $E_{\rm x}\ll E$  ( $E_{\rm x}$  — напряженность, возникающая из-за эффекта Холла), что не всегда справедливо. Поэтому в экспериментах обычно используют  $\partial uc\kappa$  Корбино. В нем напряженность внешнего электрического поля направлена радиально (контакты подсоединены к внешней и внутренней сторонам), а индукция магнитного поля — перпендикулярно плоскости диска. Магнитное поле вызывает дополнительное трансверсальное движение зарядов, которое не приводит к их накоплению. Отсюда  $E_{\rm x}=0$  и формула (4) полностью применима. Если толщина диска h, а внешний и внутренний диаметры D и d соответственно, то сопротивление диска R выражается по формуле

$$R = \frac{\rho_0}{2\pi h} \ln \frac{D}{d} \tag{5}$$

### 2. Калибровка

Экспериментальная установка. Установка в этой части практически полностью аналогично установке в соответствующей части работы 3.4.1 (вместо милливеберметра на данной установке используется датчик Холла, сразу измеряющий магнитное поле), поэтому не будем повторно приводить описание.

**Обработка результатов** Результаты измерений B(I) занесены в таблицу 1 (см. часть 3, ток обозначен  $I_{\rm m}$ ), график представлен на рисунке 1. Из него видно, что сердечник магнита почти достигает насыщения, поэтому придумать аппроксимирующую функцию довольно сложно (была проведена гладкая кривая).

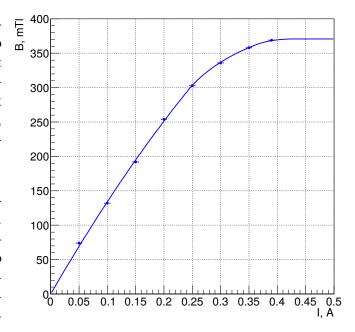


Рис. 1: График зависимости B(I)

## 3. Исследование

#### магнетосопротивления

Экспериментальная установка. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Ток I через образец, измеряемый амперметром, регулируется реостатом  $R_2$ , т.к. его сопротивление достаточно большое, значение силы тока практически не меняется в ходе эксперимента. Вольтметр измеряет напряжение U на образце. Таким образом, сопротивление измеряется формулой

$$R = \frac{U}{I},\tag{6}$$

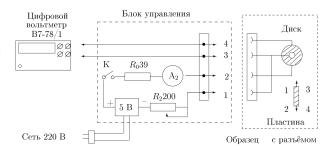


Рис. 2: Схема установки

называемой *законом Ома*. Согласно (4), зависимость  $R(B^2)$  должна быть линейной. Для ее получения будем проводить измерения на тех же токах через электромагнит, при которых производилась калибровка.

**Обработка результатов.** Экспериментальные данные вместе с пересчитанными результатами занесены в таблицу 1. Связь индексов с образцами следующая: 1 — диск Корбино, 2 — пластина с шириной вдоль магнитного поля, 3 — пластина с шириной, перпендикулярной магнитному полю. Для диска I=25,0 мА, для пластинки — 10,0 мА. Погрешности (обозначены знаком  $\Delta$ ) были вычислены по следующим формулам:

$$\Delta B = 2 \text{ MT}\pi; \tag{7}$$

$$\Delta U = 0,02 \text{ MB}; \tag{8}$$

$$\Delta I = 0,02 \text{ MA}; \tag{9}$$

$$\Delta B^2 = 2B^2 \frac{\Delta B}{B};\tag{10}$$

$$\Delta R = R\sqrt{\left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2}.$$
(11)

$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}},{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}\mathrm{A}$	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,39
В, мТл	0	74	132	192	254	303	336	358	369
$B^2$ , м ${\rm Tr}^2/10^3$	0	5,5	17,4	36,9	64,5	91,8	112,9	128,2	136,2
$\Delta B^2$ , м $\mathrm{T}\pi^2/10^3$	0	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5
$U_1$ , мВ	0,67	0,79	1,09	1,5	2,01	2,5	2,87	3,12	3,28
$U_2$ , мВ	2,69	2,73	2,79	2,87	2,95	3,02	3,08	3,11	3,13
$U_3$ , мВ	2,69	2,76	2,88	2,97	3,08	3,19	3,26	3,32	3,38
$R_1$ , мОм	27	32	44	60	80	100	115	125	131
$\Delta R_1$ , мОм	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$R_2$ , мОм	269	273	279	287	295	302	308	311	313
$\Delta R_2$ , мОм	2	2	2	2	2	2	2	2	2
$R_3$ , мОм	269	276	288	297	308	319	326	332	338
$\Delta R_3$ , мОм	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Таблица 1: Все необходимые данные

Графики зависимостей  $R\left(B\right)^2$  представлены на рис. 2. Это действительно прямые, причем для пластины нелинейные эффекты не проявляются.